



ОКП 63 4121

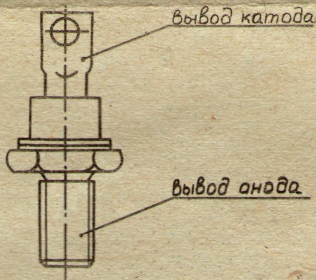
ДИОДЫ типов
АД425А, АД425Б

ЭТИКЕТКА

Арсенид-галлиевые эпитаксиальные $p-n$ импульсные полупроводниковые диоды типов АД425А, АД425Б в металлостеклянном корпусе предназначены для работы в радиотехнической аппаратуре.

Вид климатического исполнения УХЛ 2.1.

Схема расположения выводов диода



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при $t_c = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма не более
Постоянное прямое напряжение ($I_{\text{пр}} = 2 \text{ А}$), В	2
Импульсное прямое напряжение [$I_{\text{пр,и}} = 100 \text{ А}$; $t_k = (200 \pm 10)^\circ\text{C}$], В	6
Постоянный обратный ток [$U_{\text{обр}} = 600 \text{ В}$ (АД425А), $U_{\text{обр}} = 400 \text{ В}$ (АД425Б), $t_k = (200 \pm 10)^\circ\text{C}$], мА	2
Время обратного восстановления [$U_{\text{обр,и}} = 100 \text{ В}$; $I_{\text{пр,и}} = (1,0 \pm 0,1) \text{ А}$], мкс	2

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 ШТ. ДИОДОВ

Серебро — 10,9 г.

Платина — 0,0009 г.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОМ ДИОДЕ

Медь — 4,01 г.

Молибден — 0,28 г.

Никель и его сплавы — 1,4 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды типов АД425А, АД425Б соответствуют техническим условиям АДБК.432.123.000 ТУ.

По Решению № КИПД-У-056-90

29.12.90
Место для штампа
ОТК

ОТК 43

З. 371 — 300. 06.02.89.